

Программа Четвертой международной конференции

«Достижения Китайской Электронной промышленности в производстве высоконадежной ЭКБ»

29 -31 мая 2018 г.

г. Москва

Место проведения: ИКИ РАН (м. «Калужская»).

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная 84/32

Схема проезда: <http://www.iki.rssi.ru/proezd.htm>

29 мая, вторник		
1	9:00-10:00	Регистрация участников.
2	10:00	Открытие конференции.
3	10:45	Доклад Пекинского института микроэлектронной техники (ВМТИ)
4	11:30	Кофе-брейк
5	12:00	Доклад Сианьского института микроэлектронной техники (ХМТИ)
6	12:45	Доклад Шыцзячуаньского 13 Института (СЕТС)
7	13:30	Обеденный перерыв
8	14:30	Экскурсия по выставочному залу ИКИ РАН
9	15:15	Доклад Чжухайской компании аэрокосмической науки и техники ORBITA
10	16:00	Доклады специалистов ведущих космических предприятий РФ об опыте работы с китайской ЭКБ
11	18:00	Подведение итогов Заключительное слово

30 мая, среда	
9:00-17:00	Работа по секции «ПЛИС, ЦАП, АЦП, синтезатор с ФАПЧ»
9:00-17:00	Работа по секции «100В ВИП, 27В ВИП, N и P канальные транзисторы»
9:00-17:00	Работа по секции «Модули памяти: SRAM, SDRAM, MRAM, FLASH»
9:00-17:00	Работа по секции «СВЧ компоненты: УМ, МШУ, ГУН, фильтры, ОСХО, VCXO, TCXO»

31 мая, четверг	
9:00-17:00	Работа по секции «ПЛИС, ЦАП, АЦП, синтезатор с ФАПЧ»
9:00-17:00	Работа по секции «100В ВИП, 27В ВИП, N и P канальные транзисторы»
9:00-17:00	Работа по секции «Модули памяти: SRAM, SDRAM, MRAM, FLASH»
9:00-17:00	Работа по секции «СВЧ компоненты: УМ, МШУ, ГУН, фильтры, ОСХО, VCXO, TCXO»

Работа в секции – это персональные встречи российских специалистов со специалистами китайских заводов.

В ходе этой встречи российские специалисты будут ознакомлены с продукцией, детально обсудят технические вопросы и конкретные технические решения и задачи.

Для участия в работе секции необходима предварительная регистрация.

Контактное лицо по организации работы в секции: Полубояринов Антон Владимирович +7-911-77-515-77.